

p.16 下から 4 行目

誤：メインセル部とは別の設計を要する終端部を

正：メインセル領域とは別の設計を要する終端領域を

p.33 本文上から 1 行目

誤：パワーは

正：パワーMOSFET は

p.167 下から 3~4 行目

誤：電界効果トランジスタ (FET: Field effect transistor)

正：電界効果トランジスタ (Field effect transistor:FET)

p.180 図 4.5 中

誤：HVPE-grown

正：HVPE 成長した

p.211 図 5.5 中

誤：Bormashov ら[1]

正：Bormashov ら[44]

p.236 図 5.23 中

誤：4H-SiC (a-face) [3] 、4H-SiC(Si or C-face)[3]

正：4H-SiC (a-face) [3] 、4H-SiC(Si or C-face)[3]

p.236 図 5.23 キャプション

誤：〔図 5.23〕 反転層チャネルダイヤモンド MOSFET における電界効果移動度と
界面準位密度の関係

正：〔図 5.23〕 反転層チャネルダイヤモンド MOSFET における電界効果移動度と
界面準位密度の関係[97] [98]

p.278 著者紹介中段 松本 翼（まつもと つばさ）経歴中

誤：2015 年に金沢大学助教に着任し、現在に至る。

正：2015 年に金沢大学助教に着任し、現在、同准教授。